

世界最小クラス*のシリコンカーバイド ショットキーバリアダイオード (SiC-SBD)

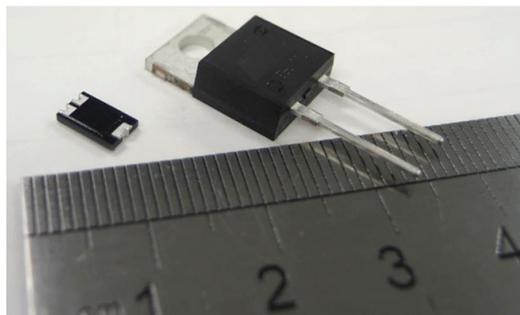
*2021/03 当社調べ



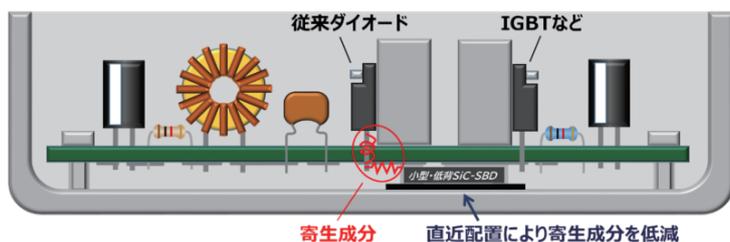
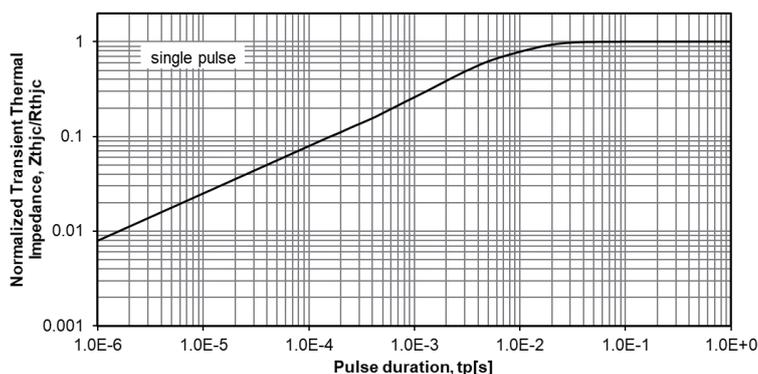
高放熱・超小型低背 クリップボンド・パッケージ搭載



4.0mm x 6.5mm x 0.9mm



TO-220 との比較



本製品のねらい

サステナブルで豊かな社会を実現するために、省資源化、高効率化が求められています。SiC SBDは低損失かつ高速なスイッチング動作が可能なパワー半導体です。

SiC SBDはSi FRDと比べ温度特性が良く、高温時にも低損失の特長があり、スイッチング時の損失となるリカバリー時間もありません。

SiCの良さをより生かすため、当社では超小型・低背・高放熱 ($R_{thjc}=2.1^{\circ}\text{C}/\text{W typ.}$) のクリップボンド・パッケージに、650V/10A 定格のSiC SBDを搭載しました。

これにより、部品サイズや放熱設計の面で実装の難しかった場所への搭載が可能となります。また、寄生成分を抑えることでノイズの低減にも効果的です。これらの特徴により、最終製品の高効率化・小型軽量化・省資源化に貢献します。



製品ラインアップ

製品名	V_{RPM} [V]	I_F [A]	V_F [V]	T_J [°C]	供給形態	サンプル
NJDCD010A065AZA1	650	10	1.5	-55 ~ 175	クリップボンド パッケージ	提供可能

定格電圧 (650V,1200V) ・電流ラインアップ拡充中。お客様のご要望に合わせてカスタマイズも可能です。

製品・サンプルについての
お問い合わせはこちらから →



New Japan Radio Co., Ltd.